

## Sensoranordnung mit mehreren potentiometrischen Sensoren

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensoranordnung zur potentiometrischen  
5 Untersuchung einer Vielzahl von Proben, insbesondere mit sogenannten ISFET  
oder CHEMFET-Sensoren. Potentiometrische FET-Sensoren der genannten  
Art sind zur Messung des PH-Werts oder des Red-Ox-Potentials eines Analyten  
geeignet. Das Patent DE 198 57 953 C2 betrifft beispielsweise die Realisierung  
eines pH-ISFET-Sensor, bei dem zur Reduzierung des Schaltungsaufwands  
10 der ISFET-Sensor als Widerstand in eine Brückenschaltung mit mindestens drei  
weiteren Widerständen angeordnet ist. Hinsichtlich der Montage eines FET-  
Sensors sind u. a. die folgenden Prinzipien bekannt. Benton offenbart in US-  
Patent- Nr. 5,833,824 einen pH-Sensor, bei dem ein ISFET-Chip mittels einer  
metallischen Dichtung, welche den ionensensitiven Bereich des ISFET-Chips  
15 umgibt an der Unterseite eines Substrats befestigt ist, wobei der ionensensitive  
Bereich mit einer Öffnung in dem Substrat fluchtet. Außerhalb des von der  
Dichtung umgebenen Bereiches werden Leiterbahnen an der Oberfläche des  
Chips zu Kontaktflächen geführt, welche über Löt- oder Schweißverbindungen  
mit komplementären Kontaktflächen an der Unterseite des Substrats verbunden  
20 sind. Die von Benton vorgeschlagene Lösung ist insofern sehr aufwendig, als  
sowohl bei der Herstellung der Dichtung als auch bei der Verwirklichung der  
elektrischen Kontaktierung aufwendige Löt- bzw. Schweißverfahren erforderlich  
sind. Der in Benton diskutierte Stand der Technik beschreibt ISFET-Sensoren,  
bei denen eine gewöhnliche polymerische Dichtung um die Öffnung der  
25 Probenkammerwand zwischen dem Substrat und dem ionensensitiven Bereich  
des ISFET-Chips angeordnet ist. Die Kontaktierung des ISFET-Chips erfolgt  
jedoch nicht zum Substrat im Sinne von Benton, sondern zu einem Träger,  
welcher den ISFET-Chip auf der von dem Substrat abgewandten Rückseite  
unterstützt. Zu diesem Zweck sind Bonddrähte zwischen Kontaktflächen an der  
30 Vorderseite des ISFET-Chips zu Kontaktflächen auf den Träger außerhalb der  
Auflagefläche des ISFET-Chips geführt. Auch diese Lösung ist aufwendig, weil  
Bondarbeiten zur Kontaktierung des Chips erforderlich sind, und weil zur

**BEST AVAILABLE COPY**

Gewährleistung der Funktion und Integrität des Sensors der Chip sowohl bezüglich des Substrats wie auch bezüglich des Trägers in engen Toleranzen ausgerichtet sein muss. Weiterhin sind Lösungen bekannt, bei denen die Chips ihre Kontaktflächen bzw. Bondpads auf der dem ionensensitiv Bereich  
5 abgewandten Rückseite aufweisen. Diese Chips können dann rückseitig über einen Träger mit komplementären Kontaktflächen kontaktiert werden, wobei zur Gewährleistung ausreichender galvanischer Kontakte zwischen der Rückseite des Chips und dem Träger ein anisotroper elastischer Leiter, z.B. eine Silikonfolie mit eingebetteten Goldfäden in einer Richtung senkrecht zur Ebene  
10 der Folie angeordnet ist. Diese Lösungen sind insofern sehr teuer, da die Führung der elektrischen Anschlüsse durch den Chip von dessen Vorderseite zu dessen Rückseite seine Herstellungskosten um ein vielfaches erhöht.

In der unveröffentlichten deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen  
15 10260961.6 der Anmelderin der gegenwärtigen Anmeldung wird eine Sensoranordnung mit einem einzelnen ISFET- bzw. CHEMFET-Sensor mit einer frontseitigen Montage mittels eines anisotropen Leiters offenbart.

Die beschriebenen Sensoranordnungen sind jeweils nur die Untersuchungen  
20 einzelner Proben möglich. Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Sensoranordnung für potentiometrische Messungen bereitzustellen, die einerseits minimalen Probenvolumina messen und andererseits mehrere Proben gleichzeitig untersuchen kann.

25 Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Sensoranordnung gemäß des unabhängigen Patentanspruchs 1.

Die erfindungsgemäße Sensoranordnung umfaßt mindestens zwei Probenkammern; mindestens zwei potentiometrische FET-Sensoren,  
30 insbesondere IsFET-Sensoren oder ChemFET-sensoren mit einem sensitiven Oberflächenabschnitt, wobei der sensitive Oberflächenabschnitt jeweils mit einer der Probenkammern in Fließverbindung steht; eine Referenzzelle mit

einem Referenzmedium zur Bereitstellung eines Referenzpotentials, wobei die Probenkammern mit dem Referenzmedium über eine Elektrolytbrücke verbunden sind.

- 5 Die Sensoranordnung ist gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung modular aufgebaut, d. h. die Probenkammern sind in einem ersten Modul angeordnet und die potentiometrischen FET-Sensoren in einem zweiten Modul.

Das erste Modul kann beispielsweise einen plattenförmigen Grundkörper aufweisen, der Bohrungen aufweist, welche als Probenkammer dienen. Im Falle von durchgehenden Bohrungen können die potentiometrischen FET-Sensoren in ein zweites Modul integriert sein, welches die Bohrungen von der Unterseite des Grundkörpers als Bodenelement verschließt. Für jede Probenkammer kann ein separates Bodenelement vorgesehen sein, oder es können mehrere Probenkammern mit einem gemeinsamen Bodenelement verschlossen werden.

Die Elektrolytbrücke kann über Elektrolytkanäle erfolgen. In einem derzeit bevorzugten Ausführungsbeispiel weist der Grundkörper die Elektrolytkanäle auf. Der Grundkörper kann einstückig sein oder aus mehreren Elementen bzw. mehreren Schichten zusammengesetzt sein. Im letzteren Fall empfiehlt es sich, daß die Elektrolytkanäle in der Grenzfläche zwischen zwei Schichten angeordnet sind.

In einer weiteren Ausgestaltung sind die Elektrolytkanäle in das zweite Modul, insbesondere das Bodenelement, integriert.

Die Referenzzelle kann ebenfalls einen potentiometrischen FET-Sensor zur Bereitstellung eines Referenzpotentials aufweisen, wobei das Referenzpotential  $U_{\text{diffref}}$  gegen das Pseudoreferenzpotential einer Potentialableitelektrode gemessen werden kann. Die Potentialableitelektrode kommuniziert ebenfalls mit dem Referenzmedium in der Referenzzelle. Die Potentialableitelektrode

kann beispielsweise einen metallischen Kontakt mit einer Silber- bzw. Silberchloridbeschichtung umfassen.

Die Potentiale  $U_{\text{diff}1}$ ,  $U_{\text{diff}2}$ , ...  $U_{\text{diff}N}$  der N FET-Sensoren in den Probenkammern werden vorzugsweise gegen das Pseudoreferenzpotential gemessen. Die messgrößenrelevante Potentialdifferenz, beispielsweise  $U_{\text{ph}1}$ , wird durch Differenzbildung zwischen dem jeweiligen Potential und dem Referenzpotential ermittelt  $U_{\text{ph}1} = U_{\text{diff}1} - U_{\text{diffref}}$ . Die Differenzbildung kann analog oder digital erfolgen.

10

Die FET-Sensoren, welche beispielsweise als vereinzelte Chips oder als eine Vielzahl von Sensorelementen in einem ggf. monolithischen Bodenelement vorliegen können, müssen zur Realisierung eines Sensors in der Weise angeordnet sein, daß sie einerseits mit den bisweilen korrosiven Proben beaufschlagt werden können, ohne daß andererseits korrosionsempfindliche Komponenten, z.B. Leiterbahnen, mit den Medien in Kontakt kommen. Hierzu werden in einer Ausgestaltung der Erfindung FET-Sensoren in der Weise angeordnet, daß die ionensensitiven Oberflächenbereiche der FET-Sensoren mit Bohrungen der Probenkammern fluchten, wobei zwischen dem Grundkörper und den FET-Sensoren eine ringförmige Dichtung angeordnet ist, welche die Bohrungen umgibt, so daß der ionensensitive Bereich des Halbleiterchips mit der Probe beaufschlagt werden kann, ohne daß die Probe mit dem FET-Sensor außerhalb des von der Dichtung eingeschlossenen Bereichs in Berührung kommt. Für die elektrische Kontaktierung der FET-Sensoren sind verschiedene Ausgestaltungen möglich.

20

25

Derzeit wird das Konstruktionsprinzip der bereits in der Einleitung erwähnten deutschen Patentanmeldung No. 10260961.6 bevorzugt. Demnach weisen die FET-Sensoren an der dem Grundkörper zugewandten Oberfläche erste Kontaktflächen auf, die mit passenden zweiten Kontaktflächen auf der dem FET-Sensor zugewandten Unterseite des Grundkörpers fluchten. Die Unterseite des Grundkörpers weist Leiterbahnen auf, über welche die zweiten

30

Kontaktflächen mit geeigneten Schaltungen zur Speisung der FET-Sensoren elektrisch verbunden sind. Zwischen der Unterseite des Grundkörpers und der Oberfläche des FET-Sensors wird eine elastische Schicht bzw. Folie angeordnet, die senkrecht zur Oberfläche des FET-Sensors zumindest  
5 abschnittsweise anisotrop leitend ist, wobei die elastische Schicht eine Öffnung aufweist, die mit der Bohrung fluchtet. Die elastische Folie bzw. Schicht dient somit einerseits als Dichtung und andererseits zur elektrischen Kontaktierung.

Vorzugsweise umfaßt die elastische isolierende Schicht oder Folie in dem  
10 anisotrop leitfähigen Bereich eingebettete leitfähige Partikel, Körner oder Fäden, insbesondere metallische Partikel oder Fäden. Besonders bevorzugt sind derzeit Goldfäden, die sich senkrecht zur Ebene der elastischen organischen Schicht erstrecken. Besonders bevorzugt sind derzeit Silikonschichten, die Goldfäden aufweisen und kommerziell von der Firma Shin-  
15 Etsu erhältlich sind.

Sofern die elastische Schicht metallische Körner aufweist, so sind diese in einer relaxierten Schicht in einer solchen Konzentration gleich verteilt, daß es nicht zu einer ausreichenden Zahl von elektrischen Kontakten zwischen den Körnern  
20 kommt, um eine elektrische Leitfähigkeit über große Distanzen herzustellen. Wird jedoch die elastische Schicht in einer Richtung komprimiert, beispielsweise durch Einspannung als Dichtelement, zwischen dem ersten Modul und dem zweiten Modul bzw. dem Grundkörper und dem Bodenelement, so entsteht in der Kompressionsrichtung eine ausreichende Zahl von  
25 elektrischen Kontakten, um die Leitfähigkeit entlang der Kompressionsrichtung zu gewährleisten. Unabhängig von der gewählten Art des Dichtelements können die FET-Sensoren bzw. das Bodenelement durch eine rückseitige Abstützung gegen die elastische Schicht gepresst werden, um die Dichtungswirkung der elastischen Schicht zu optimieren. Die rückseitige  
30 Abstützung kann sowohl steif als auch elastisch vorgespannt sein. Die elastische Vorspannung, z. B. mit einer Schraubfeder, ist insoweit vorteilhaft, als dadurch die Effekte von unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten

sicherer ausgeglichen werden können, als wenn dies ausschließlich durch die Elastizität des Dichtungselements erfolgen müsste. Dies ist insbesondere dann beachtlich, wenn ein gewisser Kompressionsgrad des Dichtungselementes erforderlich ist, um die elektrische Leitfähigkeit durch die Dichtung zu gewährleisten.

Die anderen bekannten Kontaktierungsarten des FET-Sensors, beispielsweise gemäß Benton oder gemäß des in Benton diskutierten Stands der Technik sind ebenfalls zur Realisierung der vorliegenden Erfindung geeignet, wobei bei einer Kontaktierung gemäß Benton der Nachteil in Kauf zu nehmen ist, daß eine feste Verbindung zwischen dem FET-Sensor und dem Grundkörper erfolgt, wodurch die Modularität beeinträchtigt wird.

Die Erfindung wird nun anhand eines in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiels erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2a: eine Aufsicht auf die Unterseite eines Grundkörpers für eine Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung

Fig. 2b: ein Dichtelement für eine Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 2c: einen Längsschnitt durch eine Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1 zeigt schematisch das Funktionsprinzip der erfindungsgemäßen Sensoranordnung. Die FET-Sensoren 10 der Sensoranordnung weisen jeweils

eine sensitive Gate-Region auf, welche mit einem Analyten in einer Probenkammer beaufschlagbar ist. Die einzelnen Probenkammern der Sensoranordnung sind über eine Elektrolytbrücke miteinander verbunden. Hierzu umfaßt die Elektrolytbrücke einen Elektrolytkanal 11 der über  
5 Diaphragmen mit den Probenkammern kommuniziert. Die Sensoranordnung umfaßt weiterhin eine Referenzkammer, in der eine Referenzelektrode 13, beispielsweise aus Platin, und ein Referenz-FET 12 angeordnet ist. Der Referenz-FET gibt ein Pseudoreferenzpotential  $U_{\text{diffref}}$  aus, gegen welches die Potentiale  $U_{\text{diff1}}$ ,  $U_{\text{diff2}}$ , ...  $U_{\text{diffN}}$  der N FET-Sensoren in den Probenkammern  
10 gemessen werden. Die messgrößenrelevante Potentialdifferenz, beispielsweise  $U_{\text{ph1}}$ , wird durch Differenzbildung zwischen dem jeweiligen Potential und dem Referenzpotential ermittelt  $U_{\text{ph1}} = U_{\text{diff1}} - U_{\text{diffref}}$ . Die Differenzbildung kann analog oder digital erfolgen.

15 Konstruktive Einzelheiten eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Sensoranordnung werden nun anhand der Fign. 2a, 2b und 2c erläutert.

Fig. 2a zeigt die Unterseite eines Substrats 6 mit vier Probenkammern 9 für eine erfindungsgemäße Sensoranordnung, wobei auf der Unterseite jeweils  
20 Kontaktflächen 7 und 8 beabstandet zu den Öffnungen der Probenkammern angeordnet sind. Die Kontaktflächen 7 und 8 sind jeweils über Leiterbahnen in geeigneter Weise mit den erforderlichen Anschlüssen verbunden. Bei der fertig montierten Sensoranordnung dienen die Öffnungen dazu, die Sensoren mit der zu analysierenden Probe zu beaufschlagen.

25 Fig. 2b zeigt eine Aufsicht auf ein Dichtelement für eine Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei das Dichtelement bei dieser Ausführungsform eine Silikonschicht umfaßt, in welche durchgehende Goldfäden eingebracht sind, die sich im wesentlichen senkrecht zur Ebene des  
30 Dichtelements 5 erstrecken. Auf diese Weise ist das Dichtelement in der Ebene des Dichtelements elektrisch isolierend und senkrecht zur Ebene des Dichtelements leitend. Somit können miteinander fluchtende elektrische

Kontaktflächen, welche durch die Dichtung voneinander getrennt sind, miteinander in elektrischen Kontakt gebracht werden, während bezüglich der Ebene des Dichtungselements lateral versetzte Kontaktflächen voneinander elektrisch isoliert sind.

5

Die erforderliche Mindestgröße von fluchtenden Kontaktflächen zur Gewährleistung eines sicheren Kontakts ist eine Frage der mittleren Anzahl von Goldfäden pro Flächeneinheit des Dichtelements. Dieser Parameter kann vom Fachmann in geeigneter Weise angepasst werden. Gleichmaßen ist der  
10 mittlere laterale Abstand von Bauelementen zur Gewährleistung einer zuverlässigen Isolation eine Funktion der Anzahldichte der Goldfäden sowie von deren Orientierung und deren Durchmesser. Derzeit wird ein Dichtungselement bevorzugt, welches eine zuverlässige Kontaktierung bei fluchtenden Kontaktflächen von bereits weniger als  $1 \text{ mm}^2$  ermöglicht und eine  
15 ausreichende Isolation bei einem lateralen Abstand von etwa 0,5 mm gewährleistet.

Die äußeren Abmessungen des Dichtelements in Fig. 2b sind bei dieser Ausführungsform kongruent mit den äußeren Abmessungen der Unterseite des  
20 Substrats in Fig. 2a, wobei dies nicht zwingend erforderlich ist. Das Dichtelement weist zudem für jede Probenkammer im Substrat und ggf. zusätzlich für eine Referenzkammer Öffnungen auf, welche mit den entsprechenden Öffnungen im Substrat fluchten. Es ist zweckmäßig, wenn die Öffnungen im Dichtelement etwa die gleiche Größe wie die Öffnungen in der  
25 Unterseite des Substrats 6 aufweisen. Auf diese Weise werden Totvolumina zwischen dem Substrat und einem als Bodenelement dienenden Halbleiterchip bzw. zwischen dem Dichtelement und dem Bodenelement oder dem Substrat vermieden.

30 Fig. 2c zeigt schließlich ein Längsschnitt durch eine zusammengesetzte Sensoranordnung gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei das Dichtelement 5 zwischen dem Halbleiterchip 1 und dem Substrat 6 eingespannt ist.



Der Halbleiterchip 1 weist in seiner dem Substrat 6 zugewandten Oberfläche ionensensitive Bereiche 2 auf, welcher mit den Öffnungen im Substrat 6 fluchten. Beabstandet zu den Öffnungen sind jeweils Kontaktflächen 3 und 4  
5 angeordnet, welche jeweils mit den komplementären Kontaktflächen 7, 8 auf der Unterseite des Substrats fluchten. Die Kontaktierung zwischen den chipseitigen Kontaktflächen 3, 4 und den substratseitigen Kontaktflächen 7, 8 wird durch die Leitfähigkeit des Dichtelements 5 senkrecht zu dessen Ebene gewährleistet.

10

Um eine hinreichende Dichtungswirkung zu erzielen, muss der Halbleiterchip 1 mit ausreichender Kraft gegen die Unterseite des Substrats 6 gedrückt werden. Dies kann einerseits durch eine Einspannung mit formstabilen Bauelementen erfolgen und andererseits durch eine Vorspannung mittels elastischer Elemente  
15 wie einer Schraubfeder, die hier jedoch nicht dargestellt ist.

20

Das Substrat 6 kann einstückig mit einem Gehäuse eines Halbleitersensors ausgebildet sein oder als separates Bauteil, welches in geeigneter Weise in ein Gehäuse einzusetzen ist. Diese und ähnliche Ausgestaltungen ergeben sich für den Fachmann in nahe liegender Weise, ohne vom Gegenstand der Erfindung abzuweichen, die in den nachfolgenden Patentansprüchen definiert ist.

## Patentansprüche

1. Sensoranordnung, umfassend:
  - 5       mindestens zwei Probenkammern;  
  
mindestens zwei potentiometrische FET-Sensoren, insbesondere IsFET-Sensoren oder ChemFET-sensoren, mit jeweils einem sensitiven Oberflächenabschnitt, wobei der sensitive Oberflächenabschnitt jeweils  
10       mit einer der Probenkammern in Fließverbindung steht; und  
  
eine Referenzzelle mit einem Referenzmedium zur Bereitstellung eines Referenzpotentials, wobei die Probenkammern mit dem Referenzmedium über eine Elektrolytbrücke verbunden sind.  
15
2. Sensoranordnung nach Anspruch 1, wobei die Sensoranordnung ein erstes Modul umfaßt, welches die Probenkammern aufweist.
- 20 3. Sensoranordnung nach Anspruch 2, wobei die Sensoranordnung mindestens ein zweites Modul umfaßt, welches mehrere potentiometrischen FET-Sensoren aufweist.
4. Sensoranordnung nach Anspruch 2, wobei die Sensoranordnung  
25       mindestens mehrere zweite Modul umfaßt, welche jeweils einen potentiometrischen FET-Sensor aufweisen.
5. Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 2 - 4, wobei das erste Modul einen plattenförmigen Grundkörper mit Bohrungen aufweist,  
30       welche als Probenkammer dienen.

6. Sensoranordnung nach Anspruch 5, wobei die Bohrungen durchgehend sind, und wobei das mindestens eine zweite Modul bzw. die zweiten Module als Bodenelement gestaltet sind, welche die durchgehenden Bohrungen von der Unterseite des ersten Moduls verschließen.
- 5 7. Sensoranordnung nach Anspruch 5, wobei die potentiometrischen FET-Sensoren derart in das zweite Modul integriert sind, daß jeweils ein FET-Sensor mit einer der durchgehenden Bohrungen fluchtet.
- 10 8. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Elektrolytbrücke über Elektrolytkanäle verläuft, welche in dem Grundkörper ausgebildet sind.
- 15 9. Sensoranordnung nach Anspruch 8, wobei der Grundkörper mehrere Elemente, insbesondere mehrere Schichten aufweist, und die Elektrolytkanäle in einer Grenzfläche zwischen zwei benachbarten Elementen angeordnet sind.
- 20 10. Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Elektrolytbrücke über Elektrolytkanäle verläuft, welche in dem zweiten Modul, integriert sind.
- 25 11. Sensoranordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Referenzzelle einen potentiometrischen Referenz-FET-Sensor zur Bereitstellung eines Referenzpotentials aufweist, welches gegen das Pseudoreferenzpotential einer Potentialableitelektrode erfaßt wird.
12. Sensoranordnung nach Anspruch 11, wobei die Potentialableitelektrode mit dem Referenzmedium in der Referenzzelle beaufschlagt ist.
- 30 13. Sensoranordnung nach Anspruch 12, wobei die Potentiale  $U_{\text{diff}1}$ ,  $U_{\text{diff}2}$ , ...  $U_{\text{diff}N}$  von N FET-Sensoren in den Probenkammern gegen das

Pseudoreferenzpotential ermittelt, und die messgrößenrelevanten Potentialdifferenzen, jeweils durch Differenzbildung zwischen dem jeweiligen Potential und dem Referenzpotential bestimmt  $U_{ph1...N} = U_{diff1...N} - U_{diffref.}$  werden.

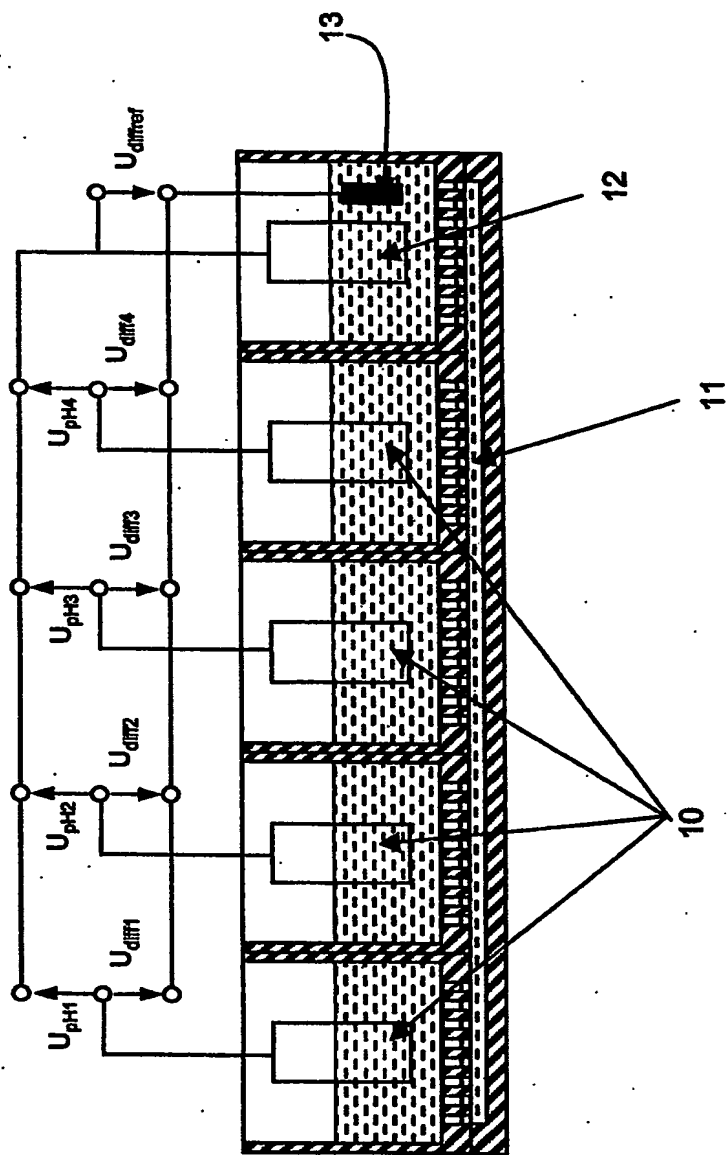
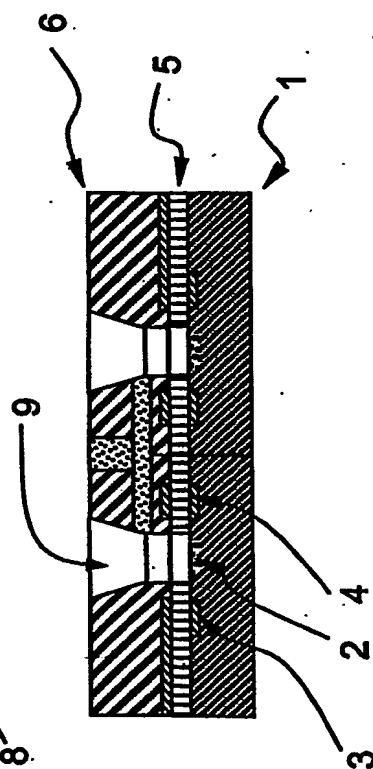
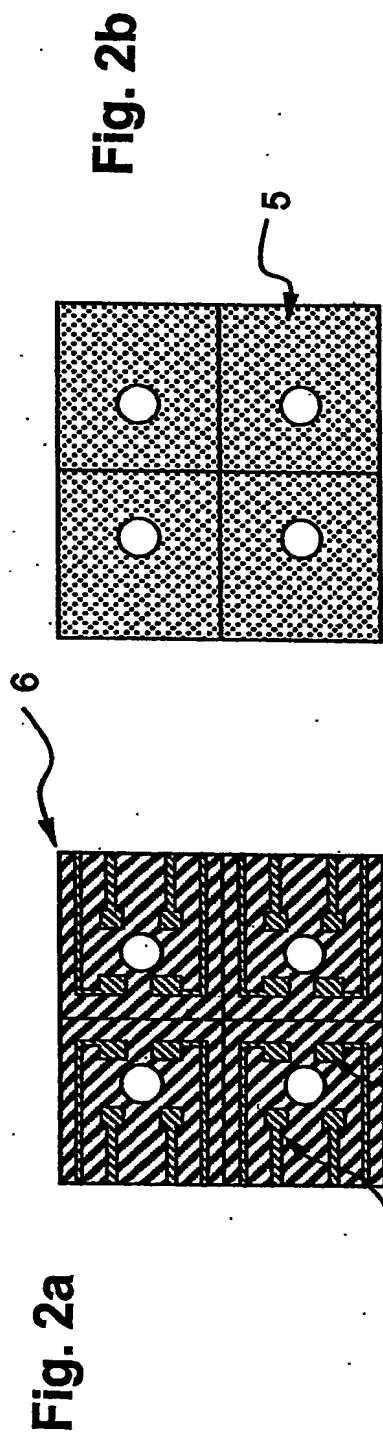


Fig. 1



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: Application No  
PCT/EP2004/012182

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G01N27/414

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/052097 A1 (HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION; MIYAHARA, YUJI; YASUDA, KENJI;) 26 June 2003 (2003-06-26) figure 11	1-13
A,P	-& EP 1 460 130 A1 (HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION) 22 September 2004 (2004-09-22) figure 11 paragraphs '0007!, '0021!, '0028!	1-13
A	US 4 874 499 A (SMITH ET AL) 17 October 1989 (1989-10-17) column 9, line 35 - line 64	1-13
A	US 5 478 526 A (SAKAI ET AL) 26 December 1995 (1995-12-26) column 5, line 12 - line 49	1-13
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 January 2005

Date of mailing of the international search report

11/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Stussi, E

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter — al Application No  
PCT/EP2004/012182

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 157 (P-288), 20 July 1984 (1984-07-20) & JP 59 052745 A (FUJITSU KK), 27 March 1984 (1984-03-27) abstract -----	1-13
A	US 2002/125133 A1 (BANNIGAN JOHN THORNTON ET AL) 12 September 2002 (2002-09-12) figure 1 -----	1-13
A	DE 198 57 953 A1 (ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GESELLSCHAFT FUER MESS- UND REGELTECHNIK MBH) 6 July 2000 (2000-07-06) cited in the application the whole document -----	1-13



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/012182

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 03052097	A1	26-06-2003	EP	1460130 A1	22-09-2004
EP 1460130	A1	22-09-2004	WO	03052097 A1	26-06-2003
US 4874499	A	17-10-1989	NONE		
US 5478526	A	26-12-1995	JP	3152727 B2	03-04-2001
			JP	5281243 A	29-10-1993
			DE	4310607 A1	14-10-1993
JP 59052745	A	27-03-1984	NONE		
US 2002125133	A1	12-09-2002	WO	0067010 A1	09-11-2000
			AU	774243 B2	24-06-2004
			AU	4093600 A	17-11-2000
DE 19857953	A1	06-07-2000	CA	2354424 A1	22-06-2000
			WO	0036408 A1	22-06-2000
			EP	1153286 A1	14-11-2001
			JP	2002532716 T	02-10-2002
			US	6624637 B1	23-09-2003

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 G01N27/414

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 03/052097 A1 (HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION; MIYAHARA, YUJI; YASUDA, KENJI;) 26. Juni 2003 (2003-06-26) Abbildung 11	1-13
A,P	-& EP 1 460 130 A1 (HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION) 22. September 2004 (2004-09-22) Abbildung 11 Absätze '0007!, '0021!, '0028!	1-13
A	US 4 874 499 A (SMITH ET AL) 17. Oktober 1989 (1989-10-17) Spalte 9, Zeile 35 - Zeile 64	1-13
A	US 5 478 526 A (SAKAI ET AL) 26. Dezember 1995 (1995-12-26) Spalte 5, Zeile 12 - Zeile 49	1-13
-/--		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Januar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/02/2005


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Stussi, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 008, Nr. 157 (P-288), 20. Juli 1984 (1984-07-20) & JP 59 052745 A (FUJITSU KK), 27. März 1984 (1984-03-27) Zusammenfassung -----	1-13
A	US 2002/125133 A1 (BANNIGAN JOHN THORNTON ET AL) 12. September 2002 (2002-09-12) Abbildung 1 -----	1-13
A	DE 198 57 953 A1 (ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS- UND REGELTECHNIK MBH) 6. Juli 2000 (2000-07-06) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-13

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern:  25 Aktenzeichen  
PCT/EP2004/012182

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 03052097	A1	26-06-2003	EP	1460130 A1	22-09-2004
EP 1460130	A1	22-09-2004	WO	03052097 A1	26-06-2003
US 4874499	A	17-10-1989	KEINE		
US 5478526	A	26-12-1995	JP	3152727 B2	03-04-2001
			JP	5281243 A	29-10-1993
			DE	4310607 A1	14-10-1993
JP 59052745	A	27-03-1984	KEINE		
US 2002125133	A1	12-09-2002	WO	0067010 A1	09-11-2000
			AU	774243 B2	24-06-2004
			AU	4093600 A	17-11-2000
DE 19857953	A1	06-07-2000	CA	2354424 A1	22-06-2000
			WO	0036408 A1	22-06-2000
			EP	1153286 A1	14-11-2001
			JP	2002532716 T	02-10-2002
			US	6624637 B1	23-09-2003

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☒ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**